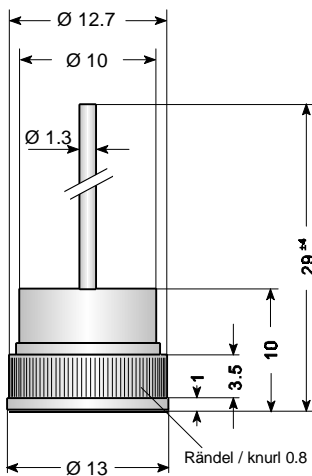


**Silicon Press-Fit-Z-Diodes**  
**High-temperature diodes**
**Silizium-Einpreß-Z-Dioden**  
**Hochtemperaturdioden**


Dimensions / Maße in mm

Power dissipation – Verlustleistung 35 W

Standard tolerance of Z-voltage ± 10 % (E12)

Standard-Toleranz der Arbeitsspannung

 Metal press-fit case with plastic cover  
 Metall-Einpreßgehäuse mit Plastik-Abdeckung

Weight approx. – Gewicht ca. 10 g

 Casting compound has UL classification 94V-0  
 Vergußmasse UL94V-0 klassifiziert

Standard: Cathode to case / am Gehäuse

Index R: Anode to case / am Gehäuse (e.g. BYZ35A22R)

Standard packaging: bulk

Standard Lieferform: lose im Karton

**Maximum ratings**
**Grenzwerte**

Type / Typ	Zener voltage <sup>1)</sup> Arbeitsspannung <sup>1)</sup> $I_Z = 100\text{mA}$ $V_Z$ [V]	Dynamic resistance Diff. Widerstand $f=1\text{kHz}, I_Z=100\text{mA}$ $r_{zj}$ [ $\Omega$ ]	Max. Z-current <sup>2)</sup> Max. Arbeitsstrom <sup>2)</sup> $T_A = 50^\circ\text{C}$ $I_Z$ [mA]
BYZ 35A22	19.6...24.4	5.0	1430
BYZ 35A27	24.1...30.0	5.5	1160
BYZ 35A33	29.6...36.5	6.5	950
BYZ 35A39	35.5...43.5	8.0	800
BYZ 35A47	42...52	9.5	670

 Max. average forward rectified current, R-load  $T_C = 150^\circ\text{C}$   $I_{FAV}$  35 A  
 Dauergrenzstrom in Einwegschtung mit R-Last

 Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur  $T_j$  – 50...+215°C  
 Storage temperature – Lagerungstemperatur  $T_s$  – 50...+215°C

Maximum pressure – Maximaler Einpreßdruck 7 kN

 Thermal resistance junction to case  $R_{thc}$  < 0.8 K/W  
 Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse

<sup>1)</sup> Tested with pulses – Gemessen mit Impulsen

<sup>2)</sup> Valid, if the temp. of the case is kept to 150°C – Gültig, wenn die Gehäusetemp. auf 150°C gehalten wird